

# THYRISTOR Type : TSN10A80

10A, 800V

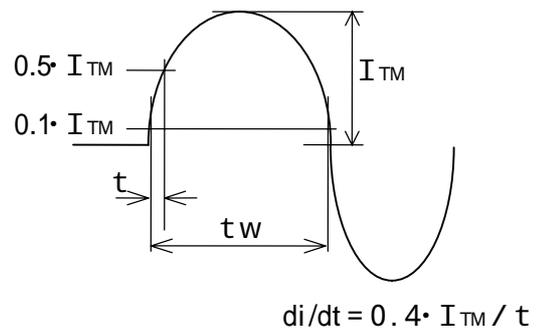
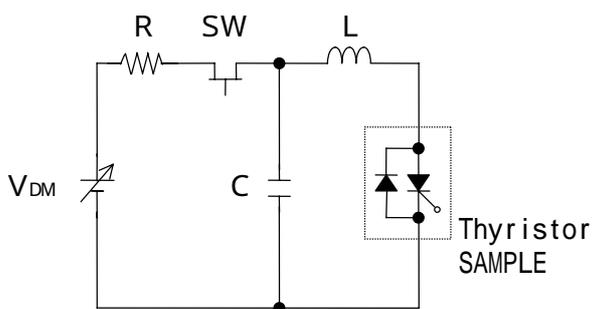
構造： シリコンプレーナ型逆導通サイリスタ

用途： HIDランプ点灯用  
コンデンサ放電制御用  
バラスト回路用

## 最大定格

項目	記号	条件	定格値	単位
繰り返しピークオフ電圧	$V_{DRM}$	$T_j = 25$	800	V
繰り返しピークオン電流 (注1)	$I_{TRM}$	$T_c 100, V_{DM} 400V$ $I_G 80mA, di/dt 0.5A/\mu s$ $t_w 1.0\mu s, di/dt 1500A/\mu s$ duty 0.005%	500	A
繰り返しピーク順電流 (注1)	$I_{FRM}$	$T_c 100, t_w 1.0\mu s$ duty 0.005%	500	A
臨界オン電流上昇率 オン電流降下率耐量 (注1)	$di/dt$	$T_a 100, V_{DM} 400V$ $I_G 80mA, dig/dt 0.5A/\mu s$ $I_{TM} 500A, t_w 1.0\mu s$ 50 Hz, 1 分間, ノイズ無し	1500	A/ $\mu s$
ピークゲート電力損失	$P_{GM}$	f 50Hz, duty 10%	5	W
平均ゲート電力損失	$P_{G(AV)}$	-	0.5	W
ピークゲート電流	$I_{GM}$	f 50Hz, duty 10%	2	A
ピークゲート電圧	$V_{GM}$	-	10	V
ピークゲート逆電圧	$V_{RGM}$	-	5	V
動作接合温度範囲	$T_{jw}$	-	-40 ~ +125	
保存温度範囲	$T_{stg}$	-	-40 ~ +150	

(注1) 回路及び波形



電気的特性 (T<sub>j</sub> = 25 )

項目	記号	条件	最小	標準	最大	単位
ピークオフ電流	I <sub>DM</sub>	V <sub>DM</sub> = V <sub>DRM</sub>	-	-	100	μA
ピークオン電圧 (サリタ)	V <sub>TM</sub>	I <sub>TM</sub> = 20A	-	-	1.50	V
ピーク順電圧 (ダイオド)	V <sub>FM</sub>	I <sub>F</sub> = 10A	-	-	1.50	V
ゲートトリガ電流	I <sub>GT</sub>	V <sub>DM</sub> = 6V , R <sub>L</sub> = 10	-	-	20	mA
ゲートトリガ電圧	V <sub>GT</sub>		-	-	1.0	V
保持電流	I <sub>H</sub>	I <sub>G</sub> = 50mA , I <sub>TM</sub> = 1A	-	7	-	mA
ラッチング電流	I <sub>L</sub>	I <sub>G</sub> = 50mA	-	13	-	mA
熱抵抗	R <sub>th(j-c)</sub>	接合部 - ケース間	-	-	5	/W
熱抵抗	R <sub>th(j-a)</sub>	接合部 - 周囲間	-	-	80	/W

外形図

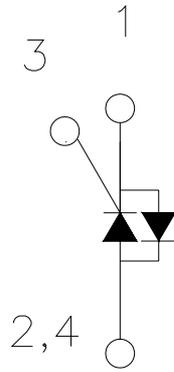
電極接続

○ : カソード

△ : アノード

□ : ゲート

重量 : 約 1.45 g



1: CATHODE

2,4: ANODE

3: GATE

